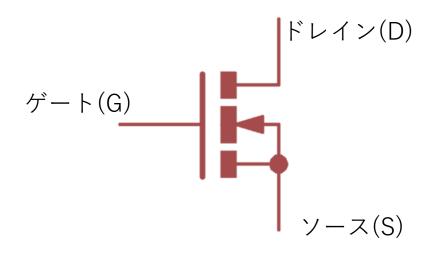
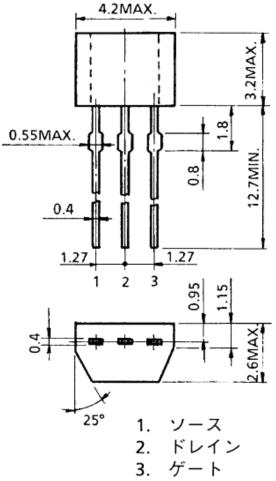
デザインプロジェクトートランジスタ増幅回路

16T2804J 入江一帆 16T2806E 齊藤陽平

実験目的

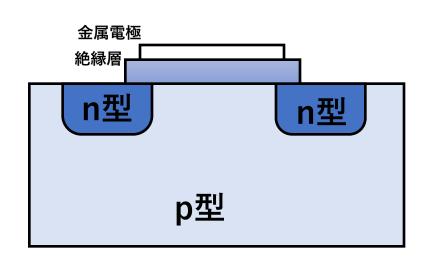
電界効果トランジスタの基本回路で あるソース接地小信号増幅回路につ いて基礎を理解する.

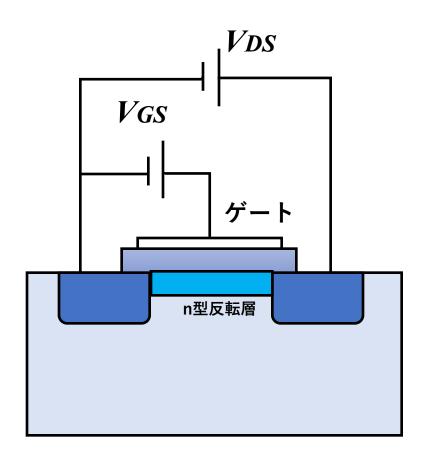




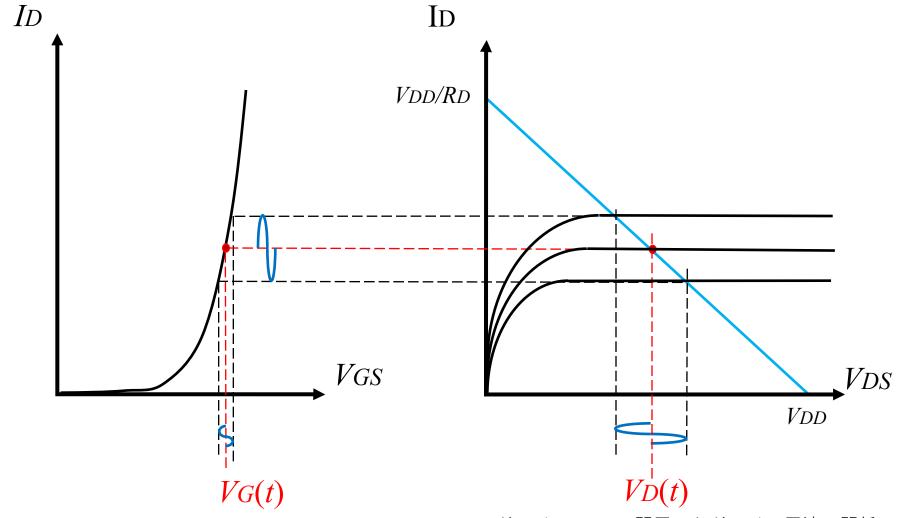
https://www.chip1stop.com/pdf/product/TOSH /2SK1825_JA_DATASHEET_071101.PDF より

原理 FETについて





原理 FETによる増幅の仕組み



ドレイン電流とゲート-ソース間電圧の関係

ドレイン-ソース間電圧とドレイン電流の関係

実験内容

- 1. ソース接地小信号増幅回路の動作確認
- 2. ソース接地小信号増幅回路の周波数特性の測定

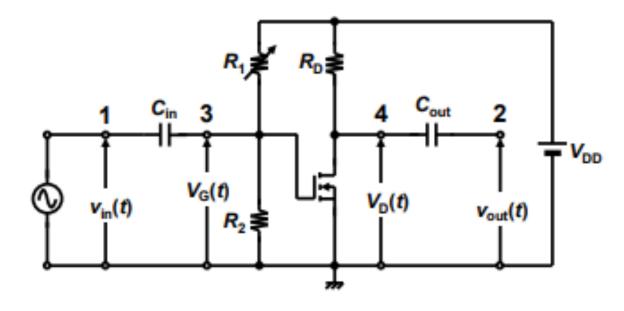


図 ソース接地増幅回路

増幅回路の動作確認 結果

回路定数

$$R_D = 4.67 \text{ k}\Omega$$
, $C_{in} = 10.65 \mu\text{F}$, $C_{out} = 10.22 \mu\text{F}$, $R_2 = 10.00 \text{ k}\Omega$

相互コンダクタンス

	下側(m)	中心 (A)	上側(p)
ゲートソース電圧	1.962 [V]	1.989 [V]	2.008 [V]
ドレイン電流	1.05 [mA]	1.28 [mA]	1.42 [mA]

∴相互コンダクタンス g_m = 8.04 mS

電圧利得と位相差について

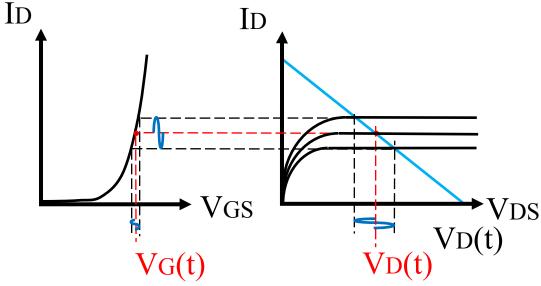
$$\Delta T = 50 \text{ µs}, \text{ vout} = 1.75 \text{V} \implies \eta v = 20 \log(35) = 30.88 \text{ [dB]}, \theta = -180 \text{ [deg]}$$

増幅回路の動作確認考察

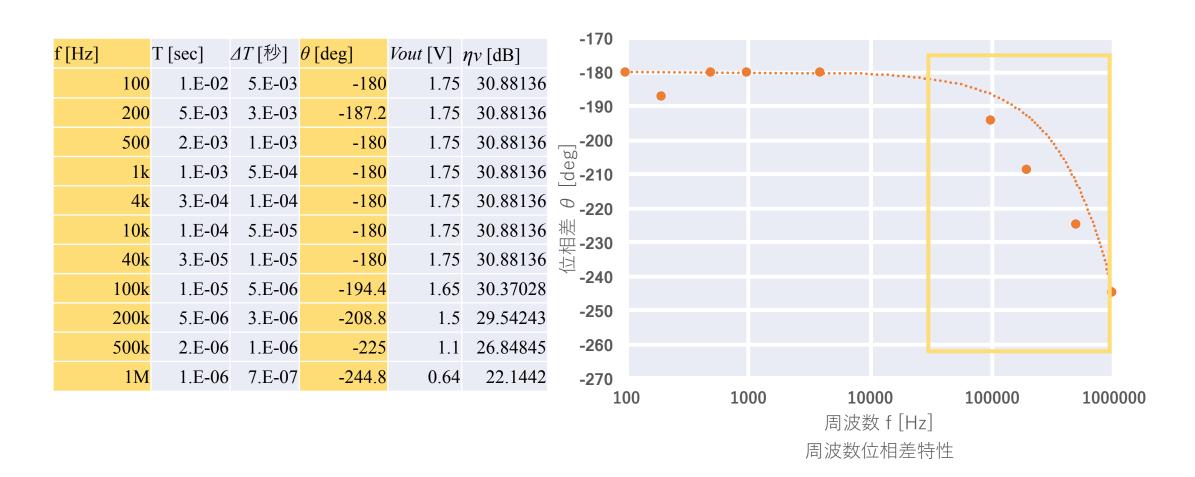
增幅率(計算值)

ドレイン電流 I_D の振幅は入力電圧の g_m 倍出力電圧の振幅は I_D の $-R_D$ 倍 ⇒電圧増幅率は $g_m \times R_D = 37.55$ 倍電圧利得 $20\log(g_m \times R_D) = 31.49$ [dB] II

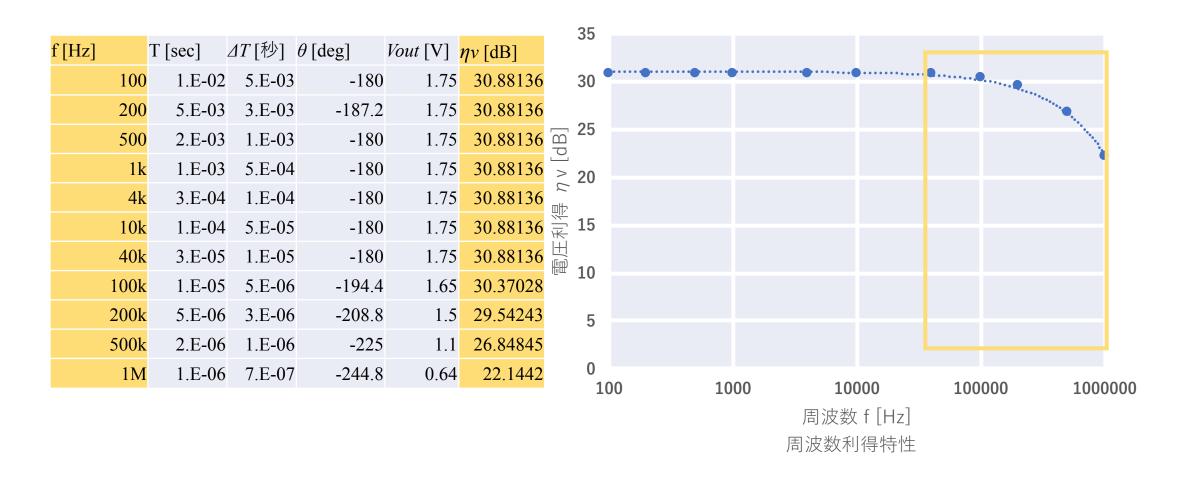
增幅率(実験結果) 35 [倍], 30.88136 [dB]



周波数特性の測定 結果



周波数特性の測定 結果



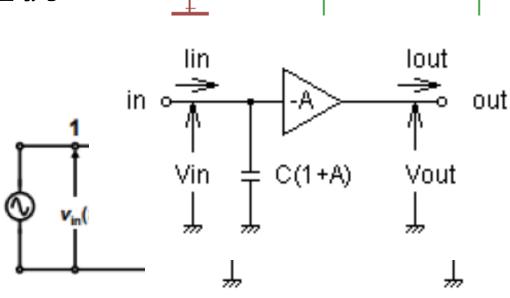
周波数特性の測定考察

高周波で利得低下, 位相遅れ ⇒ LPF

寄生容量

FET, プローブ, 負荷抵抗

ミラー効果



Cgd

DRAIN

まとめ

ソース接地増幅回路 高周波信号には**適さない** 寄生容量、ミラー効果 飽和領域で動作させる **高精度** 誤差率:約**7**%

蛇足

ボトルネックは**人間** ex. 位相差 周期⇒時間差⇒角度

細かい 細かい 少しの差が大きく影響

アナログ測定器はクソ

Index

- 1. 実験目的
- 2. 原理
- 3. 実験内容
- 4. 増幅回路の動作確認
- 5. 増幅回路の測定
- **6.** まとめ

参考サイト

"MOSFETで増幅器を設計 (1)", ディー・クルー・テクノロジーズ 美齊津摂夫 < http://eetimes.jp/ee/articles/1101/12/news108.html > , (参照2018-7/25) "MOSFETとは-寄生容量とその温度特性", rohm TechWeb, http://micro.rohm.com/jp/techweb/knowledge/si/s-si/03-s-si/4873 > , (参照2018-7/25) "ミラー効果と増幅回路の周波数特性" 京都大学原子核ハドロン物理学研究室, http://eetimes.jp/ee/articles/1101/12/news108.html > , (参照2018-7/25)